

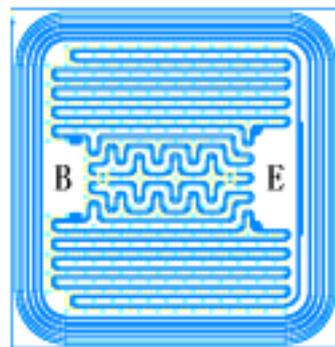


5027 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：D360AG-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：3600×3600μm²
 焊位尺寸：B 极 475×730μm²；E 极 480×900μm²
 电极金属：铝
 背面金属：银
 典型封装：KSC5027，HC5027

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

T _{stg} ——贮存温度.....	-55~150
T _j ——结温.....	150
P _C ——集电极功率耗散 (T _c =25)	50W
V _{CBO} ——集电极—基极电压.....	1100V
V _{CEO} ——集电极—发射极电压.....	800V
V _{EBO} ——发射极—基极电压.....	7V
I _C ——集电极电流 (DC)	3A
I _C ——集电极电流 (脉冲)	10A
I _B ——基极电流.....	1.5A

电参数 (T_a=25) (封装形式：TO-220)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	800			V	I _C =5mA, I _B =0
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	1100			V	I _C =1mA, I _E =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	7			V	I _E =1mA, I _C =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			10	uA	V _{EB} =5V, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			10	uA	V _{CB} =800V, I _E =0
h _{FE}	直流电流增益	10		40		V _{CE} =5V, I _C =0.2A
		8				V _{CE} =5V, I _C =1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降			2	V	I _C =1.5A, I _B =0.3A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降			1.5	V	I _C =1.5A, I _B =0.3A
f _T	特征频率		15		MHz	V _{CE} =10V, I _C =0.2A